

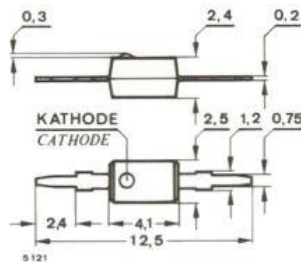
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Applications: Band selector in VHF-tuners

Abmessungen in mm
Dimensions in mm



Kunststoffgehäuse
Plastic Case
SOD 23
Gewicht · Weight
max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

Absolute maximum ratings

Sperrspannung Reverse voltage	U_R	35	V
Durchlaßstrom Forward current	I_F	100	mA
Sperrschichttemperatur Junction temperature	t_j	100	°C
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range	t_{stg}	-55...+100	°C

Wärmewiderstand

Thermal resistance

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
 $I = 4 \text{ mm}, t_L = \text{konstant}$
constant

R_{thJA} 400 °C/W

Kenngößen

Characteristics

$t_j = 25 \text{ °C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage
 $I_F = 100 \text{ mA}$

$U_F^{1)}$ 1,2 V

Sperrstrom
Reverse current
 $U_R = 30 \text{ V}$
 $U_R = 30 \text{ V}, t_j = 60 \text{ °C}$

I_R 100 nA
 I_R 1 µA

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
 $I_R = 10 \text{ µA}$

$U_{(BR)}$ 35 V

Diodenkapazität
Diode capacitance
 $f = 0,5 \text{ MHz}, U_R = 3 \text{ V}$
 $U_R = 30 \text{ V}$

C_D 1,8 pF
 C_D 1,3 pF

Differentieller Durchlaßwiderstand
Differential forward resistance
 $I_F = 5 \text{ mA}, f = 200 \text{ MHz}$

r_f 1,3 Ω

¹⁾ $\frac{t_p}{T} = 0,01, t_p = 0,3 \text{ ms}$